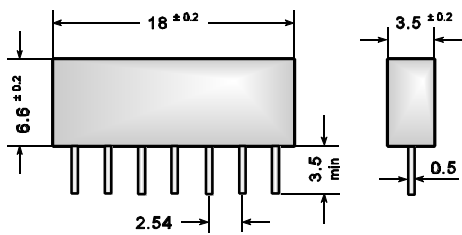


Small Signal Diode Arrays
Dioden Sätze mit Allzweckdioden


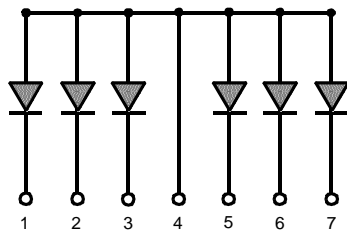
Dimensions / Maße in mm

 Nominal power dissipation / Nenn-Verlustleistung 200 mW

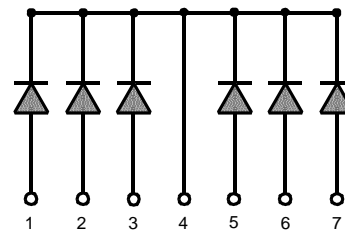
 Repetitive peak reverse voltage / Periodische Spitzensperrspannung 80 V

 7 Pin-plastic case / 7 Pin-Kunststoffgehäuse 18 x 3.5 x 6.6 [mm]

Standard packaging: bulk / Standard Lieferform: lose im Karton

 Weight approx. / Gewicht ca. 0,6 g


"DAP": com. anodes / gemeinsame Anode



"DAN": com. kathodes / gemeinsame Kathode

Maximum ratings
Grenzwerte

Type	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Typ	Periodische Spitzensperrspg.	Stoßspitzensperrspannung
	V_R [V]	V_{RM} [V]
DAN 601	80	80
DAP 601	80	80

Max. average forward rectified current, R-load, For one diode operation only	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV}	100 mA ¹⁾
For all diodes together		I_{FAV}	150 mA ¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last, Für eine einzelne Diode	$T_U = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV}	100 mA ¹⁾
Für alle Dioden zusammen		I_{FAV}	150 mA ¹⁾

Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave, superimposed on rated load, one diode only	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	500 mA
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast, für eine Diode			

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	- 50...+150°C

Characteristics			Kennwerte	
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10 \text{ mA}$	V_F	< 1 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20 \text{ V}$	I_R	< 25 nA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10 \text{ mA}$ through/über $I_R = 10 \text{ mA}$ to/auf $I_R = 1 \text{ mA}$		t_{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 85 K/W ¹⁾

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden